PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06064220 A

(43) Date of publication of application: 08.03.94

(51) Int. CI

B41J 2/44

H01S 3/096

H04N 1/04

H04N 1/23

(21) Application number: 04221368

(71) Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22) Date of filing: 20.08.92

(72) Inventor:

HATA KOJI

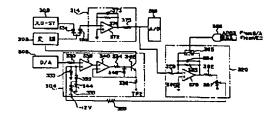
(54) IMAGE RECORDING APPARATUS

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain image quality free from density irregularity and color irregularity by controlling the supply of a current to semiconductor laser on the basis of the detected value of the output of laser beam when a photosensitive material is irradiated with laser beam so that the output of laser beam becomes a predetermined value.

CONSTITUTION: In a laser driving circuit, the beam output of a laser diode 13c detected by a photodiode 15c is inputted to a droop correction circuit 320 and an operational amplifier 378 through an I/V circuit 314 and subjected not only to amplifying and integrating processing by resistors 379, 383 and a condenser 384 but also to attenuation processing by resistors 381, 382 to be inputted to a constant current circuit 304. This inputted current is added to the current flowing to a resistor 332 and a Zener diode 344 and the added value is subtracted from the control current for a constant current inputted through a D/A converter 306. Then, the current after subtraction is applied to semiconductor laser. That is, a current wherein the beam output due to self-generation of heat is corrected is supplied to the laser beam output.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-64220

(43)公開日 平成6年(1994)3月8日

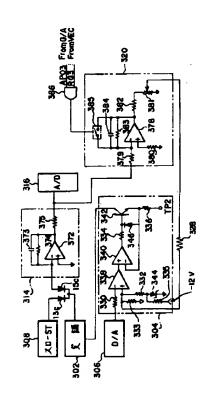
(51)Int.Cl. ⁵		識別配号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所		
B 4 1 J	2/44 3/096 1/04				•		
H 0 1 S							
H 0 4 N		10,4	7251-5C				
	1/23	103 E	9186-5C				
			7339-2C	B 4 1 J	3/ 00		M
	•			:	審査請求	未請求	請求項の数 4(全 17 頁)
(21)出顯番号 **		特願平4-221368	持顧平4-221368		000005201		
					富士写真	ミ フイル。	4株式会社
(22)出顧日		平成 4年(1992) 8月20日			神奈川県	具南足柄市	市中沼210番地
			•	(72)発明者	畑幸び	大	
					神奈川県	具足柄上	那開成町宮台798番地 富
							朱式会社内
				(74)代理人	弁理士	中島	享 (外3名)
			• .				
		<u> </u>					
			•				,
							·

(54)【発明の名称】 画像記録装置

(57)【要約】

【目的】 濃度ムラや色ムラのない安定した画像品質を 得る。

【構成】 フォトダイオード15cで検出されたレーザーダイオード13cの光出力がI/V回路314を介してドループ補正回路320のオペアンプ378へ入力され、抵抗379、383及びコンデンサ384で増幅及び積分され、抵抗381、382で減衰されて、APC回路304で、抵抗332及びツェナーダイオード344に流れる電流に加算され、この加算値がD/A306から入力される定電流用制御電流から減算された電流が半導体レーザーに供給される。従って、レーザーダイオード13cには、自己発熱による光出力が補正された電流が供給され、半導体レーザーは所定の光出力を得ることができる。



【特許請求の範囲】

供給電流に応じた出力のレーザービーム を射出する半導体レーザーと、

前記半導体レーザーから射出されるレーザービームの出 力を検出する検出手段と、

前記半導体レーザーから射出されるレーザービームを感 光材料へ走査する走査手段と、

前記感光材料へ記録する画像の濃度を表す画像データに 応じたパルス幅を有したパルス信号を形成し、該パルス 信号に基づいて前記半導体レーザーに流れる電流をパル 10 ス幅変調するパルス幅変調手段と、

前記感光材料へレーザービームが照射されているとき に、前記検出された出力に基づいて前記感光材料へ照射 されたレーザービームの出力が所定値になるように前記 半導体レーザーへ電流を供給する電流供給手段と、 を備えた画像記録装置。

【請求項2】 供給電流に応じた出力のレーザービーム を射出する半導体レーザーと、

前記半導体レーザーから射出されるレーザービームの出 力を検出する検出手段と、

前記半導体レーザーから射出されるレーザービームの主 走査及び該主走査と交差する方向の副走査を行う走査手 段と、

感光材料へ記録する画像の濃度を表す画像データに応じ たパルス幅を有するパルス信号を形成するパルス信号形 成手段と、

前記半導体レーザーに通電するための定電流を供給する 電流供給手段と、

前記パルス信号に基づいて前記電流供給手段から供給さ れた定電流をパルス幅変調して前記半導体レーザーへ供 30 給する変調手段と、

前記検出された出力に基づいて前記感光材料へ照射され たレーザービームの出力が所定値になるように前記電流 供給手段から供給される定電流の大きさを補正する補正 手段と、

を備えた画像記録装置。

【請求項3】 前記補正手段は、前記主走査の開始前ま たは終了後に前記検出された出力に基づいて前記感光材 料へ照射されるレーザービームの出力が所定値になるよ うに前記電流供給手段を補正する第1の補正手段、及び 前記主走査について1主走査中は前記検出された出力に 基づいて前記感光材料へ照射されるレーザービームの出 力が前記所定値になるように前記電流供給手段を補正す る第2の補正手段、を備えたことを特徴とする請求項2 に記載の画像記録装置。

【請求項4】 前記第2の補正手段は、画像記録領域内 について補正を行うことを特徴とする請求項3に記載の 画像記録装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、画像記録装置にかか り、特に、複数の波長を含んだ光ビームを感光材料へ露 光させることによって画像の記録を行う画像記録装置に

[0002]

関する。

【従来の技術】従来より、複数の異なる波長のレーザビ ームを混合したレーザービームによって感光材料を露光 することにより、画像を記録するレーザビームプリンタ 等の画像記録装置が知られている。

【0003】この画像記録装置の光源としては、所定の 波長帯域の光(レーザービーム)を得ることができる気 体レーザー等が用いられていたが、装置が大型になり、 かつ光出力を変調することが複雑な構成を用いなければ ならないため、最近では、小型かつ容易に光出力を変調 できる半導体レーザーが用いられるようになった。

【0004】画像露光装置には、ポリゴンミラー(回転 多面鏡)が備えられており、このポリゴンミラーに設け られた反射面へレーザービームを照射すると共に、ポリ ゴンミラーを回転させることによりレーザービームの主 20 走査を行っている。また、副走査は感光材料を移動させ て行っている。このように、レーザービームの主走査及 び副走査が行われることにより感光材料に2次元の画像 が記録される。なお、ポリゴンミラーから反射されたレ ーザービームを偏向器を介して感光材料に照射し、この 偏向器によって副走査方向にレーザービームを偏向させ 、ることにより副走査を行う場合もある。

【0005】上記半導体レーザーを用いた画像記録装置 によって感光材料に画像を記録するときは、感光材料の 発色濃度が適正になるように、濃度に応じて半導体レー ザーをパルス幅変調することによって最適な露光量のレ ーザービームで感光材料を照射している。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、半導体 レーザーは、周知のように自己発熱により光出力が変化 する、というドループ特性を有している。すなわち、半. 導体レーザーは発熱と共に光出力が低下する傾向にあ る。例えば、図16に示したように、周波数1000H z(1ms繰り返し周期)、デューティ50%のパルス信 号で半導体レーザーをパルス変調した場合、パルス信号 の立ち上がりエッジ近傍の光出力に比べて立ち下がりエ ッジ近傍の光出力が低下する。これは、パルス信号が立 ち上がり時点より、パルス信号の立ち下がり近傍のとき が自己発熱量が大きいためである。従って、画像記録装 置が継続して稼動されると、時間とともに仕上がり状態 が異なってしまう、という問題がある。

【0007】この問題を解消するために、温度調整制御 を行って、半導体レーザーの温度変化を抑制することが 考えられるが、半導体レーザーについて行った温度調整 の効果が光出力に現れるまでには長い時間を必要とする

50 ため、短時間内に発生する微妙な光出力変化を調整する

ことができない。

【0008】例えば、上記のようにポリゴンミラーを回 転させることによりレーザービームの主走査を行う場合 に、1走査内の画像データを同一にして半導体レーザー を変調して感光材料を露光しようとすると、この画像デ ータに応じたパルス変調に応じて半導体レーザーは自己 発熱により温度が上昇し、感光材料の主走査方向の前縁 に比べて所定時間を経過した後縁の光出力は低下する。 露光量が少ないと低濃度、露光量が多いと高濃度に発色 する感光材料に半導体レーザーで露光して画像形成した 10 場合、図17に示したように、中濃度(例えば、グレ ー)の1記録画像内に、略中央に髙濃度(例えば、黒) の画像を記録しようとすると、主走査方向についてグレ -の画像データのみで記録した領域A₁の濃度と黒の画 像データ後にグレーの画像データによって記録した領域 A 2 の濃度は、同一画像データで記録したにも拘わら ず、濃度が異なり、黒の後のグレーの方が低濃度にな る。このように、同一の画像データによる記録であって も1走査内における半導体レーザーの自己発熱で光出力 が異なり、画像濃度が最適にならないという問題があ る。

【0009】本発明は、上記問題を解決すべく成されたもので、濃度ムラや色ムラのない安定した画像品質を得ることのできる画像記録装置の提供を目的とする。 【0010】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために請求項1に記載の発明は、供給電流に応じた出力のレーザービームを射出する半導体レーザーと、前記半導体レーザーから射出されるレーザービームの出力を検出する検出手段と、前記半導体レーザーから射出されるレーザービームを感光材料へ走査する走査手段と、前記感光材料へ記録する画像の濃度を表す画像データに応じたパルス幅を有したパルス信号を形成し、該パルス信号に基づいて前記半導体レーザーに流れる電流をパルス幅変調するパルス幅変調手段と、前記感光材料へレーザービームが照射されているときに、前記検出された出力に基づいて前記感光材料へ照射されたレーザーで三ムが照射されているときに、前記検出された出力が所定値になるように前記半導体レーザーへ電流を供給する電流供給手段と、を備えている。

【0011】請求項2に記載の発明は、供給電流に応じ 40 た出力のレーザービームを射出する半導体レーザーと、前記半導体レーザーから射出されるレーザービームの出力を検出する検出手段と、前記半導体レーザーから射出されるレーザービームの主走査及び該主走査と交差する方向の副走査を行う走査手段と、感光材料へ記録する画像の濃度を表す画像データに応じたパルス幅を有するパルス信号を形成するパルス信号形成手段と、前記半導体レーザーに通電するための定電流を供給する電流供給手段と、前記パルス信号に基づいて前記電流供給手段から供給された定電流をパルス幅変調して前記半導体レーザ 50

4

- へ供給する変調手段と、前記検出された出力に基づいて前記感光材料へ照射されたレーザービームの出力が所定値になるように前記電流供給手段から供給される定電流の大きさを補正する補正手段と、を備えている。

【0012】請求項3に記載の発明は、請求項2に記載の画像記録装置において、前記補正手段は、前記主走査の開始前または終了後に前記検出された出力に基づいて前記感光材料へ照射されるレーザービームの出力が所定値になるように前記電流供給手段を補正する第1の補正手段、及び前記主走査について1主走査中は前記検出された出力に基づいて前記感光材料へ照射されるレーザービームの出力が前記所定値になるように前記電流供給手段を補正する第2の補正手段、を備えたことを特徴としている。

【0013】請求項4に記載の発明は、請求項3に記載の画像記録装置において、前記第2の補正手段は、画像記録領域内について補正を行うことを特徴としている。 【0014】

【作用】請求項1に記載した発明の画像記録装置は、走 査手段によって、半導体レーザーから射出されるレーザ 20 ービームを感光材料へ走査する。この半導体レーザー は、供給電流に応じたレーザービームを出力し、このレ ーザービームの出力は、検出手段によって検出される。 パルス幅変調手段は、感光材料へ記録する画像の濃度を 表す画像データに応じたパルス幅を有したパルス信号を 形成する。また、この形成されたパルス信号に基づいて パルス幅変調手段は、半導体レーザーに流れる電流をパ ルス幅変調する。この半導体レーザーには、電流供給手 段によって、感光材料へレーザービームが照射されてい るときに、検出手段によって検出された出力に基づいて 感光材料へ照射されたレーザービームの出力が所定値に なるように電流が供給される。従って、半導体レーザー から射出されるレーザービームの光出力は一定に制御さ れ、画像データに応じた濃度で感光材料を発色させるた めに半導体レーザーをパルス幅変調する自己発熱によっ て、レーザービームの光出力の変動が生じても、レーザ ービームの光出力は所定値になるように補正されるた め、感光材料には、安定した光出力のレーザービームが 照射される。

【0015】請求項2に記載した発明の画像記録装置は、走査手段を備えており、この走査手段は、半導体レーザーから射出されるレーザービームの主走査及び主走査と交差する方向の副走査を行う。半導体レーザーは、供給電流に応じたレーザービームを出力し、このレーザービームの出力は、検出手段によって検出される。この半導体レーザーには、電流供給手段によって、半導体レーザーに流れる定電流が供給される。パルス信号形成手段は、感光材料へ記録する画像の濃度を表す画像データに応じたパルス信号を形成する。このパルス信号に基づいて変調手段は、電流供給手段で生成された定電流をパ

ルス幅変調する。従って、半導体レーザーには、変調手 段によってパルス幅変調された定電流が流れ、半導体レ ーザーは、画像データに応じた出力でレーザービームを 射出することになる。補正手段は、検出手段により検出 された出力に基づいて感光材料へ照射されるレーザービ ームの光出力が所定値になるように電流供給手段から供 給される定電流の大きさを補正する。従って、画像デー タに応じた濃度で感光材料を発色させるために半導体レ ーザーをパルス幅変調することによって、レーザービー ムの光出力の変動が生じても、半導体レーザーから射出 されるレーザービームの光出力が所定値になるように補 正されるため、感光材料には、安定した光出力のレーザ ービームが照射される。

【0016】また、補正手段を、請求項3に記載した発 明のように、第1の補正手段が、主走査方向の走査の開 始前または終了後に、検出された出力に基づいて感光材 料へ照射されるレーザービームの出力が所定値になるよ うに電流供給手段を補正し、第2の補正手段が、主走査 方向の1走査中は、検出された光出力に基づいて感光材 料へ照射されるレーザービームの出力が所定値になるよ 20 うに電流供給手段を補正するようにすることもできる。 更にこの第2の補正手段は、請求項4に記載した発明の ように、画像記録領域内について補正を行うこともでき る。このようにすることによって、半導体レーザーから 射出されるレーザービームの出力は、主走査毎に、補正 されると共に、主走査方向の1走査中においても、所定 値になるように補正されるため、感光材料には、安定し た光出力のレーザービームが照射される。

[0017]

【実施例】以下、図面を参照して、本発明の実施例を詳 細に説明する。図1は本発明が適用された画像露光装置 10を示したものである。

【0018】画像露光装置10は、半導体レーザー14 a、14b及び14cを備えている。この半導体レーザ -14a、14b及び14cの各々は、後述する制御装 置40(図2参照)により駆動され、半導体レーザー1 4 a は波長が例えば、670nmである赤外域のレーザー ビームL1を射出し、半導体レーザー14b及び14c は各々810nm、750nmの波長のレーザービームL 2、 L3を射出する。また、レーザービームL1、L2 40 及びL3の波長は、感光材料36が露光されることによ り発色するマゼンタ、イエロー及びシアンの各色に対応 されている。なお、これらの波長のレーザービームL 1、L2及びL3を射出する半導体レーザー14は極め て容易に入手できるものである。

【0019】半導体レーザー14aのレーザービーム射 出側にはレーザービームし1を平行光束にするコリメー タレンズ16aが配設されると共に、コリメータレンズ 16 a から所定の間隔を隔ててシリンドリカルレンズ1 8aと反射ミラー20とが設けられている。同様に、半 50 レーザー駆動基板(LD基板)44に接続されている。

導体レーザー14b及び14cのレーザービーム射出側 には各々コリメータレンズ16b、16cが配設され、 このコリメータレンズ16b、16cから所定の間隔を 隔ててシリンドリカルレンズ18b、18cが設けられ

【0020】シリンドリカルレンズ18b、18cを透 過するレーザービームL2、L3の光路上にはダイクロ イックミラー22a、22bが配設されている。反射ミ ラー20とダイクロイックミラー22a、22bとは同 一の傾斜角度を有し、各々のレーザービームL1、L2 及びL3を同一の光路24に導く。ダイクロイックミラ -22aはレーザービームL1を透過させると共にレー ザービームL2を反射させる。一方、ダイクロイックミ ラー22bはレーザービームL1及びL2を透過させる と共にレーザービームL3を反射させる機能を備えてい る。

【0021】同一の光路24に至ったレーザービームL 1、L2及びL3は反射ミラー26、28により反射さ れた後、ポリゴンミラー30に入射される。ポリゴンミ ラー30は矢印方向に回転し、このポリゴンミラー30 により反射されたレーザービームL1、L2及びL3は f θ レンズ32を通過して面倒れ補正のためのシリンド リカルミラー34で反射され、感光材料36上を矢印A 方向に主走査される。感光材料36は図示しない副走査 手段により駆動されることにより、主走査方向に略直交 する副走査方向(矢印B方向)に搬送される。これによ り、感光材料36に画像が形成される。

【0022】上記半導体レーザー14aは、レーザーダ イオード13a及びフォトダイオード15aから構成さ れたアノードコモンタイプの半導体レーザーであり(図 2参照)、レーザーダイオード13aは制御装置40の 制御信号に応じてレーザービームL1を射出し、フォト ダイオード15aはレーザーダイオード13aから射出 されたレーザービームL1の光出力を検出する。半導体 レーザー14 bはレーザーダイオード13 b及びフォト ダイオード15bから構成されたカソードコモンタイプ の半導体レーザーであり、半導体レーザー14 c はレー ザーダイオード13c及びフォトダイオード15cから 構成されたカソードコモンタイプの半導体レーザーであ る。これらの半導体レーザー14a、14b、14c、 すなわちレーザーダイオード13a、13b、13c及 びフォトダイオード15a、15b、15cは、制御装 置40に接続されている。

【0023】〔制御装置〕図2に示したように、制御装 置4°0は、中央演算処理装置(CPU)を有するマイク ロコンピュータで構成されたメイン制御基板(VEC基 板) 42を備えている。このVEC基板42は、各々の 相互間のデータ及びコマンド等の入出力を行うための複 数のバスライン62、64、66、68を介して半導体 なお、このVEC基板42は、図示しない記憶装置を備えており、この図示しない図示しない記憶装置に他の装置、例えばホストコンピュータ等から供給される画像の 濃度に応じた画像データが記憶されている。また、VE C基板42には、半導体レーザー14a,14b,14c及び後述するECLのレシーバ202の各々の温度を計測する図示しないサーミスタが、図示しないアナログデジタル変換器を介して接続されている。

【0024】LD基板44は、ゲートアレイ回路(G/ A) 46、パルス幅変調回路 (PWM) 50、52、5 4、レーザー駆動回路 (LDD) 56、58、60、及 び温調回路 (TEM) 48から構成されている。PWM 50、52、54及びLDD56、58、60は、半導 体レーザー14a, 14b, 14cに対応して設けられ ている。このPWM50は信号線70を介してLDD5 6へ接続され、PWM52は信号線72を介してLDD 58へ接続され、PWM54は信号線74を介してLD D60へ接続されている。また、PWM50、52、5 4及びLDD56、58、60の各々は、G/A46 に、相互間のデータ及びコマンド等の入出力を行うため 20 の複数のバスライン76、78、80、82、84、8 6を介して接続されている。また、温調回路48は、G /A46に、バスライン88を介して接続されている。 【0025】(G/A)図3に示したように、ゲートア レイ回路 (G/A) 46は、白信号処理回路102、半 導体レーザーの出力を制御するための制御信号を生成す るレーザーパワー制御信号生成回路104、デコーダ回 路106を有している。このデコーダ回路106は、ア ドレスデコードを行うためのアドレスデコーダ、入出力 されるレーザーパワーのデジタルデータをラッチするた 30 めのデータラッチ回路、入力ポート及び出力ポートを含 んでいる。

【0026】白信号処理回路102は、半導体レーザー14a、14b、14cに対応する同期処理回路120、122、124を有しており、各々の同期処理回路120、122、124の各々にる。この同期処理回路120、122、124の各々には、画面の1走査線における画像記録時間だけハイレベルとなるラスタゲート信号(信号名、RG1、RG2、RG3)が入力されるように、VEC基板42が接続されている。また、同期処理回路120、122、124は、各々半導体レーザー14a、14b、14cに対応したPWM50、52、54に接続されている。

【0027】レーザーパワー制御信号生成回路104は、半導体レーザー14a、14b、14cの何れかの出力を制御するときの論理に応じた信号(信号名、AP1、AP2)が入力されるように、VEC基板42に接続されている。このレーザーパワー制御信号生成回路104は、入力された信号(AP1、AP2)を、対応する画素クロック(GC1、GC2、GC3)で同期され 50

た信号(信号名、APO1, APO2, APO3)として出力するものである。また、レーザーパワー制御信号生成回路104は、生成された制御信号(APO1、APO2、APO3)が半導体レーザー14a、14b、14cに対応するPWM50、52、54へ出力されるように接続されている。

8

【0028】デコーダ回路106は、VEC基板42に接続されている。また、デコーダ回路106は、LDD56、58、60及び温調回路48に接続されている。このデコーダ回路106には、半導体レーザーの駆動電流制御データ及び半導体レーザー(フォトダイオード)の光出力データ(信号名、DB)、デコーダ回路106を制御するための制御コマンド(信号名、CM)が入出力される。

【0029】図7には、上記半導体レーザー14aに対応する同期処理回路120の回路例を示した。同期処理回路120は、上述のようにVEC42及びPWM50と接続されている。なお、同期処理回路120にPWM50から入力される信号の詳細は後述し、この信号名を()内に記載する。

【0030】同期処理回路120は、フリップフロップ 回路130、132を備えており、フリップフロップ回 路130は、AND回路136に接続されている。フリ ップフロップ回路132は、OR回路134を介してA ND回路136に接続されている。このAND回路13 6は、バッファを介して出力される信号(信号名、RG 01)がPWM50に入力されるように接続されてい る。詳細は後述するが、この信号RGO1は、白色画素 に対応するパルス幅を除去するためのパルス幅部分を含 んだ信号である。また、フリップフロップ回路130 は、VEC42に、ラスタゲート信号(RG1)がバッ ファを介して入力データとして入力されるように接続さ れかつ、PWM50に、画素クロック(GC1)が同期 信号として入力されるように接続されている。この画素 クロック(GC1)はフリップフロップ回路132にも 同期信号として入力される。フリップフロップ回路13 2は、PWM50に、白色の画像データに対応する信号 (/FF1)がバッファを介して入力データとして入力 されるように接続されている。このAND回路134 は、PWM50に、画素クロックの遅延信号(GCS 1) が入力されるように接続されている。

【0031】なお、同期処理回路122、124は、同期処理回路120と同一の構成のため、記載を省略する

【0032】(PWM)図4に示したように、PWM50は、デジタルアナログ(D/A)変換器216を備えている。このD/A変換器216は、VEC42から入力される10ビットの画像データをアナログ信号に変換する。また、PWM50はNAND回路218を有しており、このD/A変換器216には入力される画像デー

タが、NAND回路218を介してG/A46へ出力されるように接続されている。NAND回路218は、白色の画像データに対応する信号、すなわち入力される画像データの全てのビットがハイレベルのときにローレベルそれ以外のときハイレベルの信号(信号名、/FF1)を出力する。

【0033】D/A変換器216には、レシーバ202に接続されたECL信号をTTL信号に変換する変換器212が接続され、このレシーバ202にはECLの信号である画素毎のクロック信号(画素クロック、信号名GC1)が入力されるようにVEC42が接続されている。このVEC42から入力される画素クロック(GC1)は、レシーバ202及び変換器212を介して、D/A変換器216の同期信号として用いられる。また、遅延回路210には変換器212を介してG/A46に接続され、変換器212で変換された画素クロック(GC1)のTTL信号が遅延回路210において所定時間だけ遅延(信号名、GCS1)されて、G/A46へ出力される。

【0034】レシーバ202は、積分回路204を介してコンパレータ206の一方の入力側に接続されており、コンパレータ206には画素クロック(GC1)が積分された三角波の信号波形が入力される。このコンパレータ206の他方の入力側には、D/A変換器218の出力が入力されるように接続されている。

【0035】コンパレータ206の出力側は、ゲート回路208に接続されている。このゲート回路208には、G/A46が接続されており、G/A46で生成された信号RG01, AP01が入力される。ゲート208の出力側はLDD56に接続されている。従って、PWM50において画像データに応じて変調されたパルス信号がLDD56に入力される。

【0036】なお、PWM52、54は、同様の構成の ため、詳細な説明を省略する。

(LDD) 図5に示したように、LDD56は、変調回路302を備えている。この変調回路302は、信号線70を介してPWM50及び半導体レーザー14aが有するレーザーダイオード13aのカソードに接続されている。変調回路302は、PWM50から信号線70を介して入力されるパルス信号によって、半導体レーザー14aのレーザーダイオード13aへの供給電流を切り換えて変調する回路(図14参照)である。

【0037】この変調回路302は、定電流回路304及びデジタルアナログ変換器(D/A)306を介して、G/A46に接続されている。このD/A306には、G/A46から、半導体レーザー14aの電流制御信号(信号名、DATA1)が入力される。この定電流回路304及びD/A変換器306には、電源遮断時のサージ電流を抑制するためのオフサージ対策回路310が接続されている。

【0038】定電流回路304は、所定の光出力のレーザービームが射出されるように、オートパワーコントロール(APC制御)を行うときの半導体レーザー14aのレーザーダイオード13aに、定電流を供給するための回路である(図8参照)。このAPC制御とは、周知のように、半導体レーザー14aに内蔵されたフォトダイオード15aによって光出力をモニターしながら規格光出力になるように、半導体レーザー14aをドライブするものである。

10 【0039】また、変調回路302の出力側には、バイアス回路312が接続されており、このバイアス回路312によって生成された所定のバイアス電流が供給される。このバイアス電流は半導体レーザーの自己発熱による光出力変化(ドループ)を低減するためのもので、画像記録領域及び非記録領域に拘わらず、所定の電流値に調整されている。

【0040】レーザーダイオード13aのアノードは、オンサージ対策回路308を介して12Vの電源線に接続されている。このオンサージ対策回路308は、抵抗及びコンデンサによる所定の時定数のスロースタータ回路と3端子レギュレータ(例えば、12Vを5Vにする)で構成されており、電源投入時にオンサージ対策回路308を介して供給される電源は上記時定数に応じた時間だけ遅延される。従って、12Vの電源投入時にレーザーダイオード13aのアノードに供給される電源(本実施例では5V)は遅延されるため、半導体レーザーダイオード13aのアノードは、フォトダイオード15aのカソードに接続されている。

30 【0041】また、12Vの電源線は、フォトカプラ3 18を介してG/A46に接続されており、フォトカプ ラ318は12Vの電源が供給されることによりハイレ ベルとなる信号(信号名、LDSTS)をG/A46へ 出力する。

【0042】このフォトダイオード15aのアノードは、入力された電流を電圧に変換して出力する電流電圧(I/V)変換回路314を介してアナログデジタル変換器(A/D)316に接続されている。このA/D316は、制御コマンドやフラグ等の制御信号(信号名、ADC1)を入出力するように及びA/D316によって変換されたデジタルデータ信号(信号名、ADD1)を出力するようにG/A46へ接続されている。

【0043】なお、LDD58は同様の構成のため詳細説明を省略し、LDD60については略同様の構成のため、以下、異なる部分についてのみ説明する。また、レーザーダイオード13bのカソードには、フォトダイオード13cのカソードには、フォトダイオード15cのカソードが接続されている。

50 【0044】図6に示したように、LDD60の変調回

路302には、信号線74を介してPWM54及び半導体レーザー14cが有するレーザーダイオード13cのカソードに接続されている。このレーザーダイオード13cのカソードが接続されている。

【0045】フォトダイオード15cのアノードは、I /V変換回路314を介してA/D316に接続されて いる。このA/D316は、制御コマンドやフラグ等の 制御信号(信号名、ADC3)を入出力するように及び A/D316によって変換されたデジタルデータ信号 (信号名、ADD3)を出力するようにG/A46へ接 続されている。

【0046】本実施例に用いた半導体レーザー14c (波長750nm)は、ドループ量が大きいことを考慮して、LDD60は、自己発熱による光出力変化を補正するためのドループ補正回路320を備えている。このドループ補正回路320にはI/V変換回路314の出力信号が入力されるように接続されており、ドループ補正回路320は、出力信号が、定電流回路304に入力されるように接続されている。

【0047】なお、このドループ補正回路320は、全ての半導体レーザー14a, 14b14cのLDD56、58、60に備えるようにしてもよい。

【0048】図14には、変調回路302の回路例を示 した。レーザーダイオード13aのカソードは、抵抗1 57を介してトランジスタ150のコレクタに接続さ れ、エミッタは抵抗160を介して定電流回路304へ 接続されている。トランジスタ150のベースは、半導 体レーザーをパルス変調するためのパルス信号が入力さ れるようにPWM50に接続されかつ、抵抗162を介 30 して-5 Vに接続されている。レーザーダイオード13 aのアノードは、オンサージ対策回路308に接続さ れ、かつ抵抗156を介してトランジスタ152のコレ クタに接続されている。トランジスタ152のベースは 抵抗158を介して-5Vに接続され、エミッタはトラ ンジスタ150のエミッタに接続されている。このトラ ンジスタ152のベースには、上記トランジスタ150 のベースに供給されるパルス信号の反転されたパルス信 号が入力されるようにPWM50が接続されている。な お、レーザーダイオード13 a にはコンデンサ154が 40 並列に接続されている。従って、変調回路302は、半 導体レーザーを、PWM50からのパルス信号に応じて トランジスタ150、152を交互にスイッチングする ことによって、パルス変調することができる。

【0049】図8には、定電流回路304及びオフサージ対策回路310の回路例を示した。定電流回路304は、オペアンプ340、トランジスタ342、及び抵抗336によって構成される定電流を生成する回路を有している。また、定電流回路304は減算用オペアンプ338及び電圧電流(V/I)変換用オペアンプ340を50

12

備えており、減算用オペアンプ338の一方の入力側にはD/A306から出力される信号が抵抗330を介して入力される。この減算用オペアンプ338の一方の入力側は抵抗331を介して出力側に接続されている。減算用オペアンプ338の他方の入力側は、抵抗333を介して接地されると共に抵抗332及びツェナーダイオード344を介して接地されている。また、抵抗332とツェナーダイオード344との接続点は、抵抗335を介して図示しない電源(-12V)に接続されている。

【0050】減算用オペアンプ338の出力側は、V/I変換用オペアンプ340の一方の入力側に接続されており、V/I変換用オペアンプ340の他方の入力側はトランジスタ342のエミッタに接続されている。このトランジスタ342のエミッタは、端子TP1に接続され、端子TP1は抵抗336を介して端子TP2に接続されている。また、トランジスタ342のベースは抵抗334を介してV/I変換用オペアンプ340の出力側に接続され、コレクタは変調回路302に接続されている。このトランジスタ342のベースとV/I変換用オペアンプ340の他方の入力側とはダイオード346を介して接続されている。

【0051】オフサージ対策回路310は、定電流シャ ットダウン回路322及びDAシャットダウン回路32 4を備えている。定電流シャットダウン回路322は、 レギュレータ359を有しており、レギュレータ359 の出力側は定電流回路304の端子TP2に接続されて いる。このレギュレータ359の入力側はトランジスタ 356のコレクタに接続されている。このトランジスタ 356のベースは抵抗355を介してトランジスタ35 7のコレクタに接続されている。トランジスタ356の エミッタは、抵抗354を介してベースに接続されか つ、抵抗350及びツェナーダイオード358を介して 接地されている。トランジスタ356のエミッタは、抵 抗351、353を介してトランジスタ357のベース に接続されると共に、抵抗351、353の接続点は抵 抗352を介して接地されている。トランジスタ357 のエミッタはツェナーダイオード358のアノードに接 続されている。また、トランジスタ356のエミッタに は、-12Vの負電源が供給されるように図示しない電 源に接続されている。

【0052】DAシャットダウン回路324は、レギュレータ360を有しており、レギュレータ360の出力側はD/A306に接続されている。以下、定電流シャットダウン回路322と同一構成のため、記載を省略する。

【0053】図9には、図6のI/V変換回路314及びドループ補正回路320の回路例を示した。I/V変換回路314は、オペアンプ372を有して電流電圧変換回路が構成され、オペアンプ372のマイナスの入力

30

ている。

ることになる。

14

側はフォトダイオード15cに接続され、このオペアン プ372の入力側と出力側とに抵抗374及びコンデン サ373が並列に接続されている。このオペアンプ37 2のプラスの入力側は接地されている。また、オペアン プ372の出力側は抵抗375を介してA/D316に 接続されている。

【0054】ドループ補正回路320は、オペアンプ3 78を備えており、このオペアンプ378のマイナスの 入力側は I / V変換回路 3 1 4 からの出力信号が抵抗 3 79を介して入力されるように接続され、このオペアン 10 プ378の入力側と出力側とにはアナログスイッチ38 5、抵抗383及びコンデンサ384が並列に接続され ている。このオペアンプ378のプラスの入力側は抵抗 380を介して接地されている。また、オペアンプ37 8の出力側は抵抗382、可変抵抗381及び抵抗32 8を介して定電流回路304の減算用オペアンプ338 のプラス側に接続されている。上記アナログスイッチ3 85は、VEC42から出力される信号(RG3)及び G/A(APO3)の論理積によって制御されるように AND回路386の出力側に接続されている。

【0055】 (TEM) 図10には、温調回路(TE M)の回路構成の一例を示した。このTEMは、パワー トランジスタの通電時における発熱を利用してパワート ランジスタをオンオフすることによって温度を制御する ものであり、本実施例では、レシーバ202の温度調整 に、加熱及び加熱停止するための回路TEM48(図1 0 (1) 参照) を適用させ、半導体レーザー14a, 1 4 b, 1 4 c の温度調整に、強加熱、弱加熱及び加熱停 止するための回路TEM49(図10(2)参照)を適 用させている。

【0056】TEM48は、フォトカプラ402を備え ており、フォトカプラ402の入力側の一方は抵抗40 1を介して5 V電源に接続され、他方はG/A46から の信号が入力されるように接続されている。フォトカプ ラ402の出力側の一方は接地され、他方はオペアンプ 404のプラス側に入力される。このオペアンプ404 のプラス側は、抵抗403を介してアナログ用5V電源 に接続されている。オペアンプ404の出力側は抵抗4 06を介してパワートランジスタ408のベースに接続 され、このパワートランジスタ408のエミッタがオペ アンプ404のマイナス側に入力されるように接続され ている。また、パワートランジスタ408のエミッタは 抵抗410を介して接地され、パワートランジスタ40 8のコレクタは24Vの電源に接続されている。

【0057】従って、G/A46から、このTEM48 ヘハイレベルの信号が入力されると、フォトカプラ40 2はオフし、オペアンプ404の入力は5Vになる。従 って、このオペアンプ、パワートランジスタ408及び 抵抗410の構成により、パワートランジスタ408に は定電流が流れ、パワートランジスタ408は、発熱す 50

【0058】TEM49は、2個の素子からなるフォト カプラ412を備えており、各々の素子の入力側の一方 は抵抗423、425を介して5V電源に接続され、他 方のH端及びL端にはG/A46からの異なる信号が入 力されるように接続されている。このフォトカプラ41 2の出力側の各一方は接地され、各他方は抵抗415、 4 1 7を介してアナログ用 5 V電源に接続されている。 また、フォトカプラ412の出力側の各他方は、抵抗4 13、414を介して加算回路420に入力されるよう に接続されている(プラス側)。この加算回路420の 出力側とマイナス入力側とには抵抗418が並列に接続 され、マイナス入力側は抵抗416を介して接地されて いる。また、加算回路420の出力側はオペアンプ42 2のマイナス側に接続されている。オペアンプ422の 出力側は抵抗424を介してパワートランジスタ426 のベースに接続され、このパワートランジスタ426の エミッタがオペアンプ422のマイナス側に入力される ように接続されている。また、パワートランジスタ42

【0059】従って、G/A46から、このTEM49 のH端及びL端へ入力される信号に応じて、フォトカプ ラ412から出力され加算回路420に入力される電流 が変化し、加算回路420に入力される信号が増減す る。例えば、TEM49のH端にハイレベルの信号及び L端にローレベルの信号が入力されると、フォトカプラ 412の1つがオンし他の1つがオフし、オペアンプ4 20には抵抗417、413と抵抗414による分圧が 入力される。一方、H端にローレベルの信号及びL端に ハイレベルの信号が入力されると、オペアンプ420に は抵抗415、414と抵抗413とによる分圧が入力 される。従って、オペアンプ422、パワートランジス タ426及び抵抗428の構成により、パワートランジ スタ426には加算回路420から出力される信号に応 じた定電流が流れ、パワートランジスタ408は、強と 弱とに発熱することになる。

6のエミッタは抵抗428を介して接地され、パワート ランジスタ426のコレクタは24Vの電源に接続され

【0060】(実施例の作用)以下、本実施例の作用に ついて説明する。図示しない電源スイッチが投入され、 制御装置40に電源が供給される。このとき、各半導体 レーザーにはオンサージ308を介して電源が供給され るため、サージ電流が抑制され、半導体レーザーの劣化 及び破壊が抑制される(図5参照)。次に詳細は後述す るが、図示しない記憶装置から供給される画像データに 基づいて、PWM50において画像濃度に応じたパルス 幅のパルス信号が生成され、LDD56においてこのパ ルス信号で変調された信号によって、半導体レーザー1 4 aが駆動され、所定の露光量のレーザービームL1が 半導体レーザー14 aから射出される。同様に、PWM

52、54で生成されたパルス信号により、LDD58、60で変調された信号によって、各々対応する半導体レーザー14b,14cが駆動され、所定の露光量のレーザービームL2、L3が射出される(図2参照)。半導体レーザー14a、14b,14cから射出された各々のレーザービームL1、L2、L3は、光路24に混合され反射ミラー26、28、ポリゴンミラー30、fθレンズ32及びシリンドリカルミラー34を介して感光材料36に照射される。これにより、感光材料36に照射される。これにより、感光材料36には画像データに応じた露光量のレーザービームが照射され、所定の発色濃度が得られることにより、画像が形成される(図1参照)。

【0061】ここで、本実施例の制御装置40は、レーザー駆動回路(LDD)内に電源遮断時のサージ電流を抑制するためのオフサージ対策回路310を有している。

【0062】図8に示したように、制御装置40に電源が投入されているときには定電流シャットダウン回路322では、トランジスタ357のベースへ抵抗351、353を介して電流が供給され、トランジスタ357がオンする。従って、抵抗355が通電され、トランジスタ355がオンして、レギュレータ359は、入力された-12Vの電圧を-8Vに変換して出力する。ウンジスタ362のベース、端子TP2の電圧は-8Vに変換して、カウンジスタ362がオンして、抵抗369の通電によりって、抵抗365、368を介して電流が供給され、トランジスタ362がオンして、抵抗369の通電によりー12Vの電源が供給される。従って、D/A306には-8Vの電圧が入力される。

【0063】定電流回路304では、VEC基板42から入力される予め設定された半導体レーザーに流す電流値であるAPC制御電流データがD/A306でアナログ値(例えば、電圧値)に変換される。その変換まれる。その変換また出力電圧、及びツェナーダイオード344のツェナーダイオード344のツェナーでででででである。その減算用オペアンプ338に入力する。その減算用オペアンプ338に入力する。その減算用オペアンプ338に入力され、オペアンプ338に入力され、オペアンプ338に変換される。この定電流が変調ででででであるため、この電位差によって抵対336に流れる電流が変調回路302へ供給される。

【0064】この定電流シャットダウン回路322に供給されている-12Vの電源が低下(例えば、-10V)すると、トランジスタ357の抵抗351、353によるバイアス条件が崩れ、トランジスタ357がオフする。これにより、レギュレータ359から電圧が出力50

されなくなり、端子TP2の電圧は不定となるが、この端子TP2には、抵抗336を介して端子TP1に接続されているため、端子TP2の電圧は端子TP1に近づく方向で変動する。従って、変調回路302へ供給される電流は減少する変動することにより、半導体レーザー14aの光出力が定格以上になることはない。

【0065】また、本実施例では、D/A306には、上記定電流シャットダウン回路322と同一の構成のDAシャットダウン回路324によって、電圧が供給される。従って、DAシャットダウン回路324に供給される。従って、DAシャットダウン回路324に供給される一12Vの電源が低下すると、D/A306には電圧が供給されなくなり、D/A306の出力が停止される。このため、端子TP1の電圧についても、端子TP2の電圧方向へ変動するようになる。従って、端子TP1及び端子TP2の電位差が減少する方向に電圧が変動することにより、半導体レーザー14aの光出力が定格以上になることはない。

【0066】従って、停電や、制御装置の電源スイッチがオンされているときの電源プラグの脱着のときような電源オフ時においても、半導体レーザーにはサージ電流が流れることがない。これによって、半導体レーザーの劣化及び破壊を抑制することができる。従って、画像露光装置においては、半導体レーザーの劣化による光出力の微弱な変動が、色ムラや濃度ムラとなり、品質に高い画像形成が困難となるが、本実施例によれば、この半導体レーザーの劣化を抑制することができるため、画像品質の高い画像露光装置を継続的に提供することができる

【0067】なお、上記オフサージ対策回路310とし て、定電流シャットダウン回路322及びDAシャット ダウン回路324を用いて半導体レーザーへの供給電流 を遮断するようにしたが、定電流シャットダウン回路3 22及びDAシャットダウン回路324の何れか一方を 用いたときにおいても充分な効果を得ることができる。 【0068】ここで、感光材料36の発色濃度について 図15を参照して説明する。感光材料36は、最小発色 濃度Dmin 及び最大発色濃度Dmax を有しており、この 濃度間で露光量logEに対する発色濃度Dの特性を有 している(図15(3)参照)。従って、最小発色濃度 40 Dmin に対応する最小露光量Emin 未満の露光量で、感 光材料36を照射しても、所望の発色濃度を得ることが できない。このため、画像データに対応するパルス幅の 信号を生成しても、所定の露光量(最小露光量Emin) までの画像データによる発色は適正に行われないことに なる(図15(1)参照)。そこで、本実施例では、画 像データによる画像濃度が最小(例えば、指示濃度が 0) のときには、パルス信号のパルス幅を0にしてい る。さらに本実施例では、最小濃度に発色させるための 画像データに対応するパルス幅を、最小露光量Emin に 対応させるようにしている。すなわち、画像データによ

る指示濃度が最小値のときパルス幅を0に設定しかつ画像データによる指示濃度が最小値を越えた最小の画像データのときパルス幅を15nsecに設定している。従って、画像データと露光量との関係は、指示濃度が0を除いて最適な露光量と対応させることができる(図15(2)参照)。これによって、感光材料には画像データに基づく最適な発色濃度の画像が形成される。

【0069】この半導体レーザーの光出力を画像データ に応じて変調するためのパルス信号形成について詳細に 説明する。

【0070】図11には、PWM50の各所における信号の波形を示した。図4に示したように、レシーバ202には、画素クロックGC1(図11(1))がVEC基板42から入力される。積分回路204は、この画素クロックGC1を積分して、三角波形の信号230(図11(3))を出力する。また、D/A216には、画像データ(図11(2))が入力され、D/A216はこの画像データに応じた電圧の信号(図11(3))を出力する。コンパレータ206は、この信号230及び信号232を比較し、三角波の信号230が信号232を越えたときにハイレベルの信号(図11(4))234を出力する。この信号234は、白色の画素を形成するための画像データ(例えば、10ビットD/Aなら3FF)に対応する信号236を含んでいる。

【0071】画像データはNAND218による論理積の信号(/FF、図11(5))がG/A46へ出力され、G/A46において後述する信号RG01(図11(6))が形成され、ゲート回路208に入力される。ゲート回路208は、この信号RG01及び信号AP01(図11(7))の論理和の信号により、信号236がゲートされた信号238は、上記白色画素に対応するパルス幅の信号236が除かれ白信号補正されたパルス幅の信号のみになる。この信号238は、信号線70を介してLDD50へ出力される。

【0072】次に、上記白信号補正のためのパルス信号 (RG01)の形成について説明する。

【0073】図12には、G/A46における白信号処理回路102の同期処理回路120の各所における信号の波形を示した。図7に示したように、同期処理回路120のフリップフロップ回路130では、入力されるラスタゲート信号RG1(図12(1))が画素クロックGC1(図12(2))の立ち上がりで同期された信号が形成される。また、フリップフロップ回路132に入力される信号(/FF、図12(5))も画素クロックGC1で立ち上がりで同期される。この信号(/FF)の同期された信号(図12(6))と画素クロックGC1が所定時間遅延かつ反転された信号(/GCS1、図12(4))とのOR回路134による論理和の信号(図12(7))について、AND回路136で上記同

期されたラスタゲート信号RG1との論理積が求められ、この論理積出力(図12(8))がPWM50へ出力される。

【0074】このように、画像の記録を指示するためのラスタゲート信号RG1が画素クロックGC1で同期されかつ、白色画素に対応するパルス幅の信号236(図11参照)が除かれた信号RG01が形成される。

【0075】従って、半導体レーザーの変調時には、白色画素に対応するパルス幅の信号236は除去されているため、微弱な光出力が生じることなく、最適な色再現を実現できる。また、複数の画像を重ねて露光するときのような多重露光を行う場合においても、微弱な光によるかぶりを防止することができる。

【0076】また、本パルス幅変調は、最小パルス幅以下の制御が必要なく、階調分解能を上げることができる。すなわち、最小濃度に発色させるための画像データに対応するパルス幅を、最小露光量に対応させているため、感光材料が発色しない露光量である短いパルス幅の制御を行う必要がなく、階調分解能を上げることができる。

【0077】上記説明したように、画像データに応じたパルス幅の信号で半導体レーザーが変調されるが、一般に半導体レーザーは、ドループ特性を有しており、パルス幅変調時の半導体レーザーの自己発熱により光出力が変化する。この自己発熱による光出力変化は、時定数が何100μsというレベルのため、温度調整では制御することができない。例えば、1走査内を同一画像データで変調した場合は前縁に比べ後縁の光出力が低下する

(前画像の履歴を受ける)。このため、本実施例の制御 装置40は、ドループ補正回路320を備えている。 【0078】ドループ補正回路320には、図9に示し たように、レーザーダイオード13cから射出される光 出力(図13(1))を検出したフォトダイオード15

この電流出力が、I/V変換回路314において電圧 (図13(2))に変換されて入力される。この入力された信号を、ドループ補正回路320は、アナログスイッチ385がオフの場合に、オペアンプ378で反転増幅すると共に、抵抗383及びコンデンサ384の時定数に応じて積分する。この積分された信号は、可変抵抗381で減衰されて(図13(3))、定電流回路304の減算用オペアンプ338のプラス入力側へ出力される。従って、定電流回路304の減算用オペアンプ338のプラス入力側の電圧は、ツェナーダイオード344で制限された電圧(-6.9V)に図13(3)に示した信号が加算された信号(図13(4))になる。

【0079】上記アナログスイッチ385は、ラスタゲート信号RG3及び信号APO3の論理積、すなわち画像記録領域のときオフ、非画像記録領域のときオンになる。従って、非画像記録領域のときは、ドループ補正回50 路320から0Vが出力されるリセット状態とされるた

19 め、各走査時においてドループ補正を行うときは、前回 の走査時のドループ補正を影響を受けることはない。

【0080】このように、フォトダイオード15cで検 出したレーザーダイオード13cの光出力に応じて、画 像記録領域に対する時間だけ半導体レーザーに供給する 電流を補正するため、ラスタゲート信号のハイレベルに 対応する1走査の間に、半導体レーザー14 cの光出力 が補正することができる。従って、得られる画像の画質 を低下させることなく、画像を形成することができる。 【0081】なお、ドループ補正回路を付加しないでド 10 ループの影響による画質劣化を防ぐ方法として、上記パ ルス幅変調するための半導体レーザーの最小パルス幅及 び最大パルス幅の差を、各々の半導体レーザーが有する ドループ量に応じて変更する方法がある。すなわち、ド ループ量が大きな半導体レーザーはその差を小さくし、 ドループ量が小さな半導体レーザーはその差を大きくす る。このようにすることによってドループ量の均一化が 図れ、カラー画像を形成するときの色相変化の少ない画 像を形成することができる。更に、上記最小パルス幅及

【0082】なお、本実施例では、3個の半導体レーザーを使用して画像を形成する場合について説明したが、半導体レーザーの数量に限定されるものではなく、1個以上の何れの半導体レーザーについて本発明を適用してもよい。

び最大パルス幅の差を大きくした半導体レーザーは、ダ

イナミックレンジが大きくなる。

【0083】また、上記実施例では、画像露光装置として画像を記録する場合について説明したが、光電変換素子等を用いて画像情報を得る読取り再生装置にも容易に適用できる。

【0084】また、上記実施例では、半導体レーザーの自己発熱による光出力の補正をアナログ的に行うようにしたが、半導体レーザーを変調するパルス幅を変化させ補正するようにしてもよい。この場合、記憶されている画像データに、フォトダイオードで測定した光出力に基づく補正量を加算することによって、パルス幅を変化させることができる。

[0085]

【発明の効果】以上説明したように請求項1に記載した発明によれば、レーザービームの出力が所定値になるよ 40 うに半導体レーザーへ電流が供給されるため、濃度ムラや色ムラのない安定した画像を得ることができる、という効果がある。

【0086】請求項2に記載した発明によれば、感光材料へ交差する主走査及び副走査の走査時において、レーザービームの出力が感光材料に記録する画像濃度に対応するように半導体レーザーに流れる電流を制御するため、記録する画像の全面に亘って安定した光出力のレーザービームを照射することができ、濃度ムラや色ムラのない安定した画像を得ることができる、という効果があ 50

る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明が適応可能な画像露光装置の概略を示す 構成図である。

20

【図2】本実施例の画像露光装置の制御装置の内部構成を示すブロック図である。

【図3】 LD基板のゲートアレイ回路の構成を示すブロック図である。

【図4】 L D 基板のパルス幅変調回路の構成を示すブロック図である。

【図5】 L D基板のレーザー駆動回路の構成を示すブロック図である。

【図6】 L D 基板のドループ補正回路を含んだレーザー 駆動回路の構成を示すブロック図である。

【図7】同期処理回路の内部構成の一例を示すブロック 図である。

【図8】図5のオフサージ対策回路の構成の一例を示す 回路図である。

【図9】図6のドループ補正回路の構成の一例を示す回20 路図である。

【図10】本実施例の温調回路の構成の一例を示す回路図である。

【図11】図4のパルス幅変調回路の各信号のタイムチャートを示す線図である。

【図12】図3の同期処理回路の各信号のタイムチャートを示す線図である。

【図13】図6のドループ補正回路に関係する各信号のタイムチャートを示す線図である。

【図14】図5の変調回路の構成の一例を示す回路図で 30 ある。

【図15】(1)は画像データと露光量の関係を示した 線図、(2)は本実施例の画像データと露光量の関係を 示した線図、(3)は感光材料における露光量と発色濃 度の関係を示した線図である。

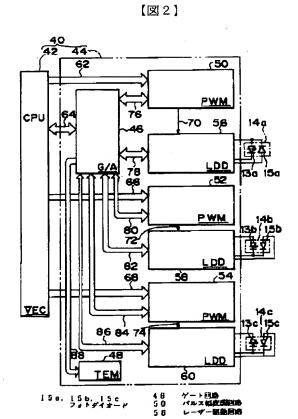
【図16】 半導体レーザーのドループ特性を説明するための光出力を示す線図である。

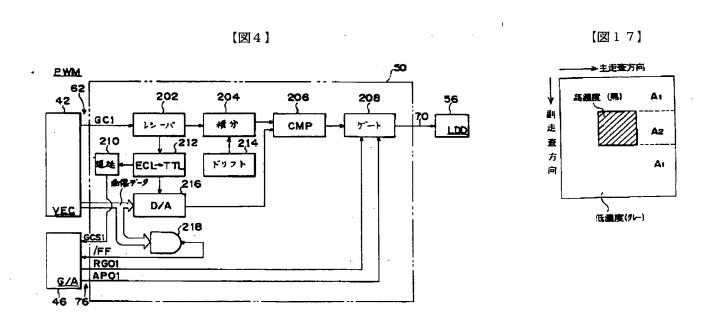
【図17】ドループ特性を有する半導体レーザーにより 同一画像データが記録された感光材料における発色濃度 の状態を示すイメージ図である。

10 【符号の説明】

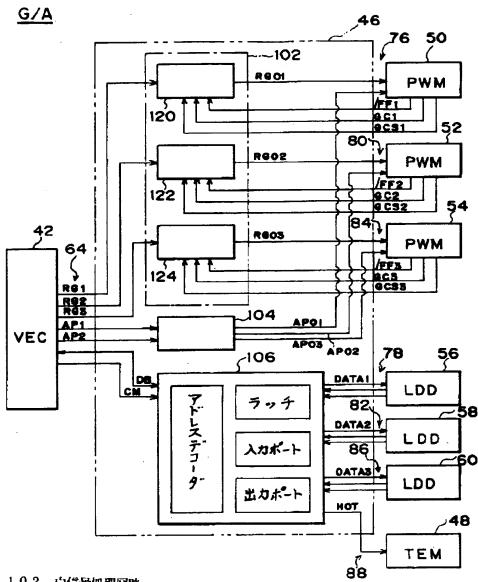
- 10 画像露光装置
- 14 半導体レーザー
- 13a レーザーダイオード
- 15a フォトダイオード(検出手段)
- 40 制御装置
- 50 パルス幅変調回路
- 56 レーザー駆動回路
- 302 変調回路(パルス幅変調手段)
- 304 定電流回路(電流供給手段)
- 0 310 オフサージ対策回路

320 ドループ補正回路



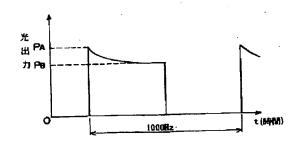


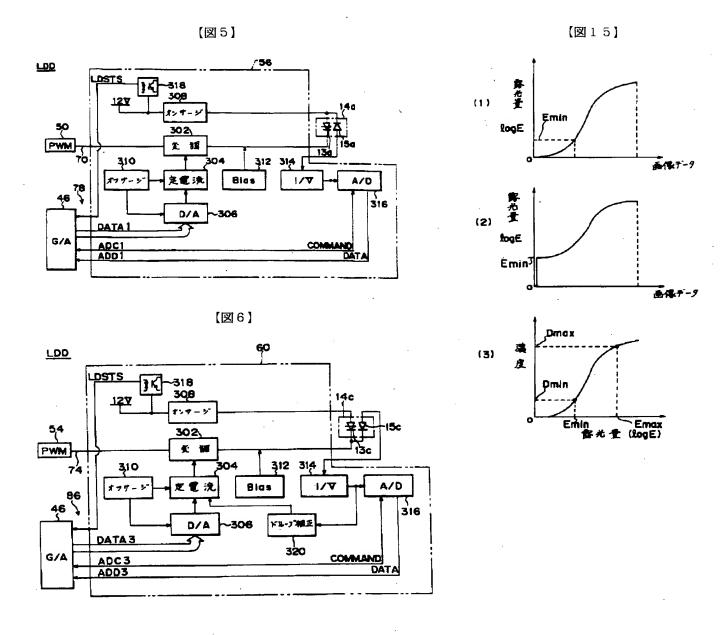
【図3】



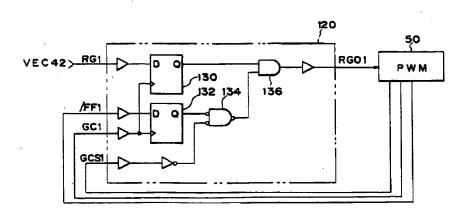
- 102 白信号処理回路
- 120 同期処理回路

【図16】

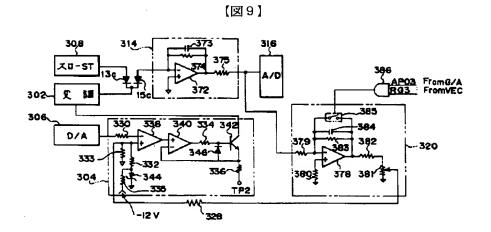




【図7】



| (図 8) (図 1 1) (Z 1 1) (



342 トラングスタ

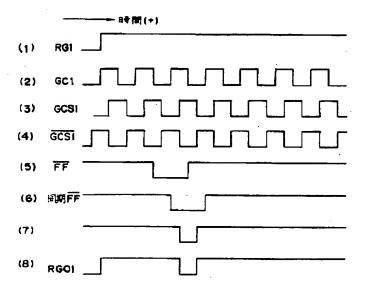
(1) 5VA 49 415 417 418 24マ

(2)

308 302 154 157 150 PWM A P C 304

【図14】

【図12】



【図13】

